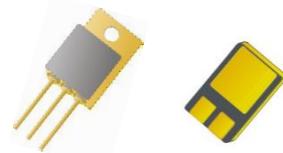




LYCS30P100 型大功率 P 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1B 级；
- 封装形式：TO-254/SMD-1。



TO-254 型 SMD-1 型

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

产品型号 参数	P_D^a ($T_c=25^\circ\text{C}$) W	V_{GS} V	I_{DM1} ($T_c=25^\circ\text{C}$) A	I_{DM2} ($T_c=100^\circ\text{C}$) A	$R_{th(j-c)}$ °C/W	T_j °C	T_{stg} °C	封装 形式
LYCS30P100(R)T	125	±20	-30	-21	1.0	-55~+150	-55~+150	TO-254
LYCS30P100(R)U								SMD-1

^a当 T_c 超过 25°C 时，按 $1.0\text{W}/^\circ\text{C}$ 线性降额。

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_D=-0.25\text{mA}$	-100	—	—	V
2	开启电压	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=-0.25\text{mA}$	-2.0	3.2	-4.0	V
3	导通电阻	$R_{DS(\text{ON})}$	$V_{GS}=-10\text{V}$, $I_D=-21\text{A}$	—	—	65	$\text{m}\Omega$
4	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=-100\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$	—	—	5	μA
5	正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-20\text{V}$	—	—	-10	μA
6	反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}$	—	—	10	μA
7	开启延迟时间	$t_{d(\text{ON})}$	$V_{DD}=-50\text{V}$, $V_{GS}=-10\text{V}$, $I_D=-15\text{A}$, $R_G=9.1\Omega$	—	30	—	ns
	上升时间	t_r		—	100	—	ns
	关断延迟时间	$t_{d(\text{OFF})}$		—	85	—	ns
	下降时间	t_f		—	65	—	ns
8	栅电荷	Q_g	$V_{DD}=-80\text{V}$, $I_D=-11\text{A}$ $V_{GS}=-16\text{V}$	—	210	—	nC
		Q_{gs}		—	22	—	nC
		Q_{gd}		—	30	—	nC
8	电容	C_{iss}	$V_{DS}=-25\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$	—	7802	—	pF
		C_{oss}		—	252	—	pF
		C_{rss}		—	211	—	pF



5 特性曲线

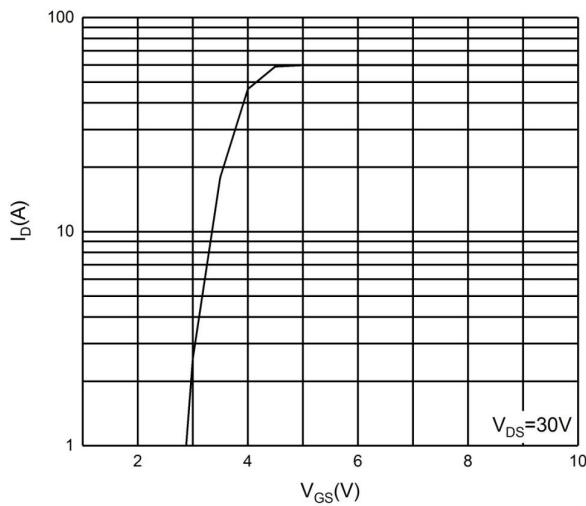


图 1 转移特性曲线

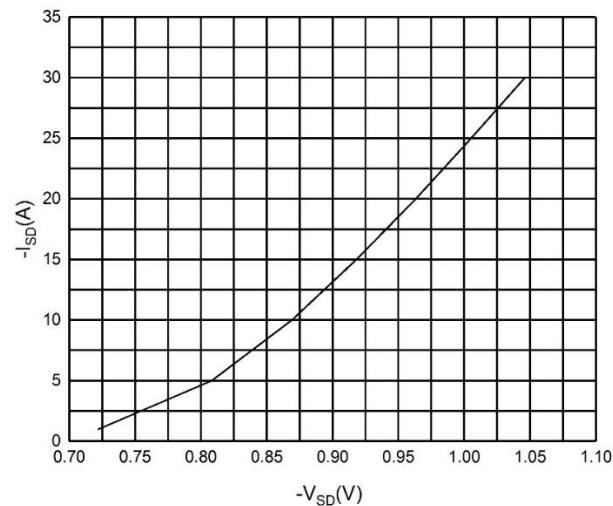


图 2 体二极管特性曲线

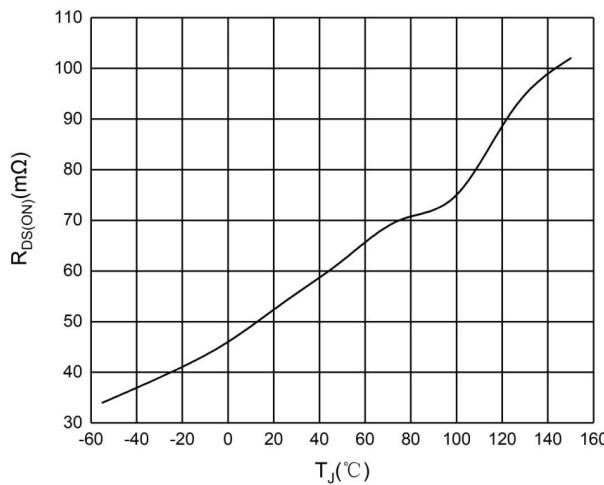
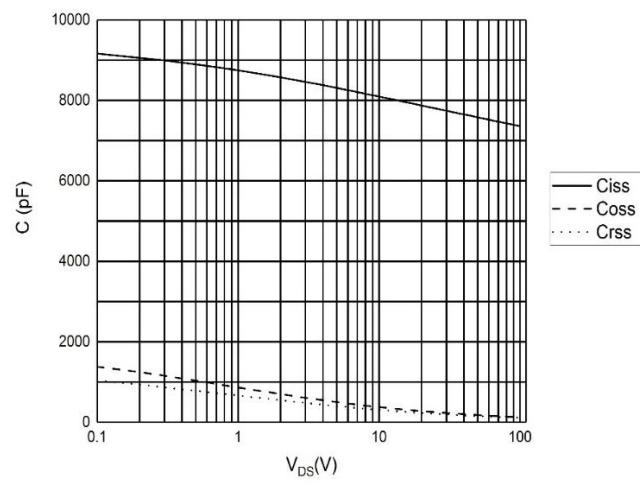
图 3 $R_{DS(on)}$ - T_J 特性曲线

图 4 电容曲线

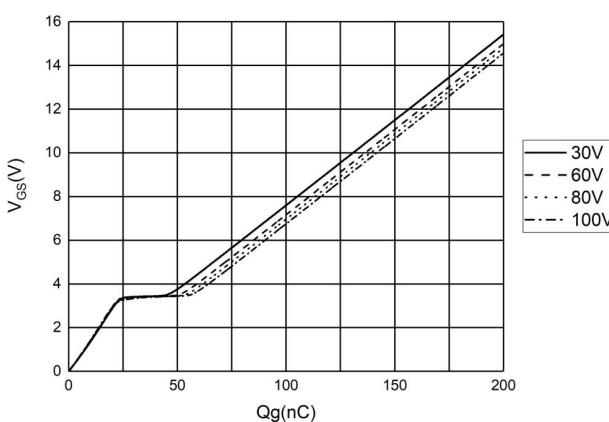
图 5 V_{GS} - Q_g 特性曲线

图 6 安全工作区曲线